








	<h2 style="color: orange;">IPI60R280C6XKSA1</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IPI60R280C6XKSA1</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 13.8A TO262</p> <p>Datenblätter:  IPI60R280C6XKSA1.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPI60R280C6XKSA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 13.8A TO262
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 430µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO262-3
Serie	CoolMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	280 mOhm @ 6.5A, 10V
Verlustleistung (max)	104W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	950pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	43nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	13.8A (Tc)

IPI60R280C6XKSA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPI60R280C6XKSA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPI60R280C6XKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPI60R280C6XKSA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPI60R199CPXKSA2 Infineon Technologies HIGH POWER_LEGACY</p>	 <p>IPI60R299CP INFINEON IPI60R299CP INFINEON</p>	 <p>IPI60R380C6XKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V 10.6A TO262</p>	 <p>IPI60R199CPXKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V 16A I2PAK</p>
 <p>IPI60R380C6 Infineon IPI60R380C6 Infineon</p>	 <p>IPI60R299CPXKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V 11A I2PAK</p>	 <p>IPI60R250CPAKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 12A TO-262</p>	 <p>IPI60R250CP INFINEON IPI60R250CP INFINEON</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPI60R280C6XKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPI60R280C6XKSA1 Datenblatt	IPI60R280C6XKSA1-Datenblätter	IPI60R280C6XKSA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPI60R280C6XKSA1
IPI60R280C6XKSA1 Electronic	IPI60R280C6XKSA1-Komponenten	IPI60R280C6XKSA1-Verteiler	IPI60R280C6XKSA1-Bild	IPI60R280C6XKSA1-Teil
IPI60R280C6XKSA1 Preis	IPI60R280C6XKSA1 Hersteller	IPI60R280C6XKSA1 Bild	IPI60R280C6XKSA1 Aktie	IPI60R280C6XKSA1 Inventar
IPI60R280C6XKSA1 Neu	IPI60R280C6XKSA1 Original	IPI60R280C6XKSA1 garantiert	IPI60R280C6XKSA1 RFQ	IPI60R280C6XKSA1 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited